



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H1609

对应国外型号
2SD1609

主要用途

音频放大、功率放大

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	——贮存温度.....	-45~150
T_j	——结温.....	150
P_C	——集电极功率耗散 ($T_A=25$)	1.25W
V_{CBO}	——集电极—基极电压.....	160V
V_{CEO}	——集电极—发射极电压.....	160V
V_{EBO}	——发射极—基极电压.....	5V
I_C	——集电极电流.....	100mA

外形图及引脚排列

TO-126ML



- 1 发射极, E
- 2 集电极, C
- 3 基极, B

电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	160			V	$I_C=10\mu A, I_B=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	160			V	$I_C=1mA, R_{BE}=\infty$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	$I_E=10\mu A, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			10	μA	$V_{CB}=140V, I_E=0$
h_{FE1}	直流电流增益	60		320		$V_{CE}=5V, I_C=10mA$
h_{FE2}		60				$V_{CE}=5V, I_C=1mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			2	V	$I_C=30mA, I_B=3mA$
C_{ob}	共基极输出电容			3.8	pF	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$
f_T	特征频率		140		MHz	$V_{CE}=5V, I_C=10mA$

分档及其标志

B	C	D
60—120	100—200	160—320